

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第3区分

【発行日】平成30年4月26日(2018.4.26)

【公表番号】特表2018-503045(P2018-503045A)

【公表日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【年通号数】公開・登録公報2018-004

【出願番号】特願2017-527343(P2017-527343)

【国際特許分類】

F 2 7 D	3/12	(2006.01)
C 2 2 C	27/04	(2006.01)
C 2 2 C	27/02	(2006.01)
C 2 3 C	24/04	(2006.01)
H 0 1 G	13/00	(2013.01)
H 0 1 G	9/052	(2006.01)

【F I】

F 2 7 D	3/12	Z
C 2 2 C	27/04	1 0 1
C 2 2 C	27/02	1 0 3
C 2 2 C	27/04	1 0 2
C 2 3 C	24/04	
H 0 1 G	13/00	3 7 1 Z
H 0 1 G	9/05	K

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月13日(2018.3.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 6】

本発明のプロセスは、その低いプロセス温度の故に、好適には、また、酸化物、炭化物、窒化物、W、Mo及びニオブ(Nb)からなる群から選ばれる1以上の成分0.001~1.0質量%を含有するTa合金の製造を可能にする。溶射操作の後、W、Mо及びNbは、Taマトリクス中に個別の粒子として存在する。セラミックス又は金属(例えば、W及びMо)の硬い構成成分は、層厚に好ましい効果をもたらす。というのは、前もって堆積された層の構成成分が硬い粒子の衝突によって圧縮されるからである。